

2T203 F

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры p-n-p усилительные.

Предназначены для применения в усилителях и импульсных устройствах.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами.

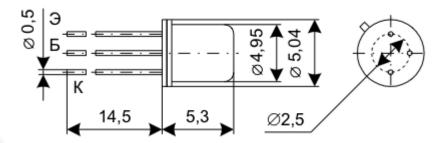
Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 0,5 г.

Тип корпуса: КТ-1-7.

Технические условия: ЩЫЗ.365.007 ТУ.

Изготовитель - AOOT «Элекс», г. Александров.



Основные технические характеристики транзистора 2Т203Г:

- h21э Статический коэффициент передачи тока для схем с ОЭ: не менее 40;
- frp Граничная частота коэффициента передачи тока: не менее 10 МГц;
- Ікэо Обратный ток коллектора при Uкб = 60 В: не более 1 мкА;
- Ск Емкость коллекторного перехода при при Uкб = 5 В: не более 10 пФ;
- Uкб max Максимальное напряжение коллектор-база: 60 В;
- Uкэr max Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при Rбэ ≤ 2 кОм: 60 В;
- Uэбо max Максимальное напряжение эмиттер-база: 30 В;
- Ік тах Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 10 мА;
- Ік и max Максимальный импульсный ток коллектора при tи ≤ 10 мс: 50 мА;
- Рк тах Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: не более 150 мВт.
- tокр температура окружающей среды: -60...+125°C.